

Market News

Superjunction-MOSFETs für Leistungsfaktorkorrektur (PFC)- und Flyback-Topologien: Die neuen 950-V-CoolMOS P7-Leistungsschalter von Infineon

München – 22. August 2018 – Hoch performante Low-Power-Schaltnetzteile benötigen immer mehr Hochvolt-MOSFETs. Infineon Technologies AG führt für diese Anwendungen ein neues Mitglied aus seiner [CoolMOS™](#) P7-Familie, die 950-V-CoolMOS P7 Superjunction-MOSFETs, ein. Die neuen Leistungsschalter erfüllen höchste Design-in-Anforderungen in [Beleuchtungsanwendungen](#), Smart-Metern, mobilen Ladungssystemen, [Notebook-Adaptern](#), externen Stromversorgungen und industriellen [Schaltnetzteil](#)-Applikationen. Sie bieten ein ausgezeichnetes thermisches Verhalten und eine hohe Effizienz, während die Bauteile- und Fertigungskosten gesenkt werden.

Die neuen 950-V-CoolMOS P7 im DPAK-Gehäuse haben einen sehr geringen Durchlasswiderstand $R_{DS(on)}$ für hoch effiziente Designs. Darüber hinaus ermöglichen die ausgezeichneten Spezifikationen für die Gate-Source-Spannung (geringe $V_{GS(th)}$ -Spannung mit geringster Toleranz) ein einfaches Ansteuern und Integrieren der neuen MOSFETs. Wie die anderen Komponenten der leistungsfähigen P7-Familie, bieten auch die neuen Leistungsschalter eine integrierte Zener-Diode als Schutz bei elektrostatischen Entladungen (ESD). Damit wird die Bestückung vereinfacht, während sich zusätzlich eine geringere Fehlerrate im Feld und geringere Kosten bedingt durch elektrostatische Produktionsfehler ergeben.

Die neuen 950-V-CoolMOS-P7 Bauelemente ermöglichen eine Erhöhung des Wirkungsgrades um bis zu einem Prozent und eine um 2 bis 10 °C geringere MOSFET-Temperatur für sehr effiziente Designs. Im Vergleich zu den Vorgänger-Generationen der CoolMOS-Familie konnten die Schaltverluste nochmals um bis zu 58 Prozent reduziert werden. Damit sind sie um etwa 50 Prozent geringer im Vergleich zu entsprechenden Wettbewerbs-Technologien.

Die 950-V-CoolMOS-P7 MOSFETs sind in verschiedenen Gehäusen verfügbar: TO-220 FullPAK, TO-251 IPAK LL, TO-252 DPAK und SOT-223. So kann von Durchsteck-Varianten (THT) auf SMT-Bestückung gewechselt werden.

Verfügbarkeit

Die neuen 950-V-CoolMOS P7 MOSFETs sind bereits verfügbar. Weitere Informationen findet man unter: www.infineon.com/950v-p7.



Für die Fachpresse

Informationsnummer INFPMM201808.077d

Infineon Technologies AG

Media Relations:

Volker Gieritz

Tel.: +49 89 234-36572

volker.gieritz@infineon.com

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655

investor.relations@infineon.com